

(19)



(11)

EP 1 748 493 A8

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN CORRIGEE

Avis: La bibliographie est mise à jour

(15) Information de correction:

Version corrigée no 1 (W1 A1)
Bibliographie code(s) INID 71

(51) Int Cl.:

H01L 29/78 (2006.01)

(48) Corrigendum publié le:

15.08.2007 Bulletin 2007/33

(43) Date de publication:

31.01.2007 Bulletin 2007/05

(21) Numéro de dépôt: **06117667.3**

(22) Date de dépôt: **21.07.2006**

(84) Etats contractants désignés:

**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI
SK TR**

Etats d'extension désignés:

AL BA HR MK YU

(72) Inventeurs:

- **Villaret, Alexandre**
38000, Grenoble (FR)
- **Mazoyer, Pascale**
38420, Domène (FR)
- **Ranica, Rossella**
38000, Grenoble (FR)

(30) Priorité: **26.07.2005 FR 0552307**

(71) Demandeur: **STMicroelectronics Crolles 2 SAS**
38920 Crolles (FR)

(74) Mandataire: **de Beaumont, Michel**

1bis, rue Champollion
38000 Grenoble (FR)

(54) **Cellule mémoire à un transistor à corps isolé à sensibilité de lecture améliorée**

(57) L'invention concerne une cellule mémoire à un transistor MOS formé dans une région de corps flottant (1) isolée sur sa face inférieure par une jonction. Une

région (41) du même type de conductivité que la région de corps flottant mais plus fortement dopée que celle-ci est disposée sous la région de drain (10) du transistor MOS.

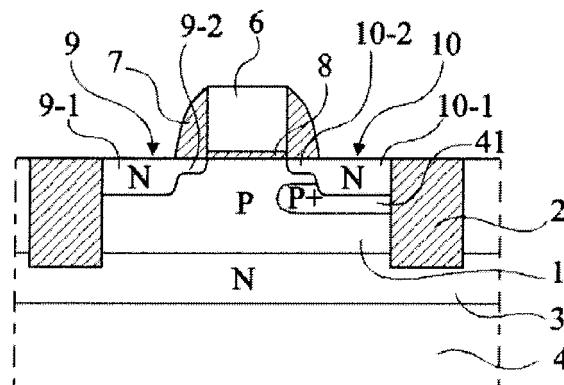


Fig 5

EP 1 748 493 A8